

Первоначальный образец, NeSe2

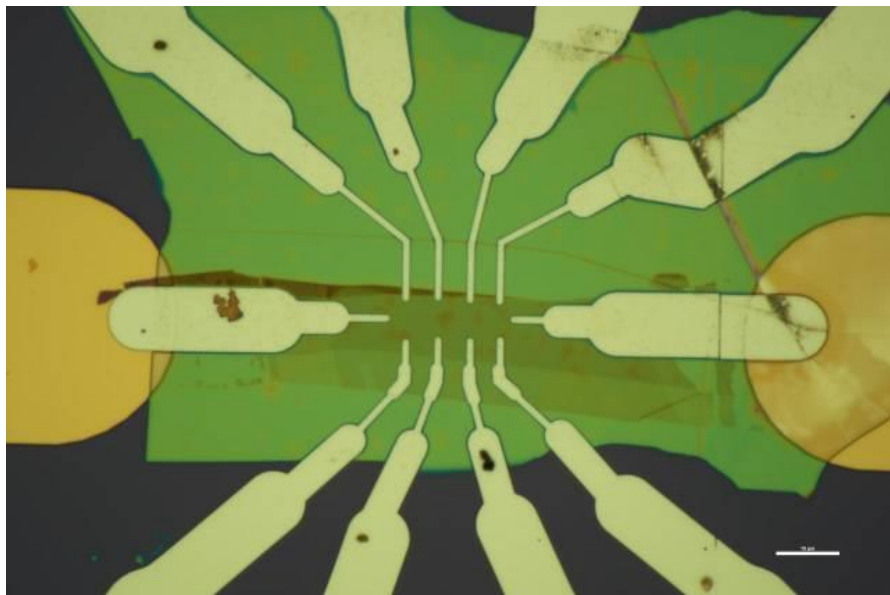
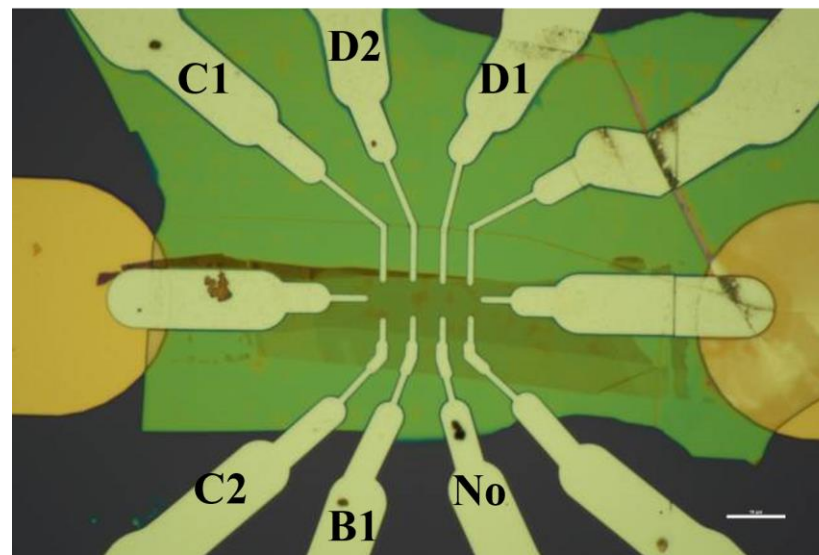


Схема измерений № 2



B1(+) -> D2(-) токозадающие

C1(+) -> C2(-)  $R_{xx4}$

D1(+) -> C1(-)  $R_{xy4}$

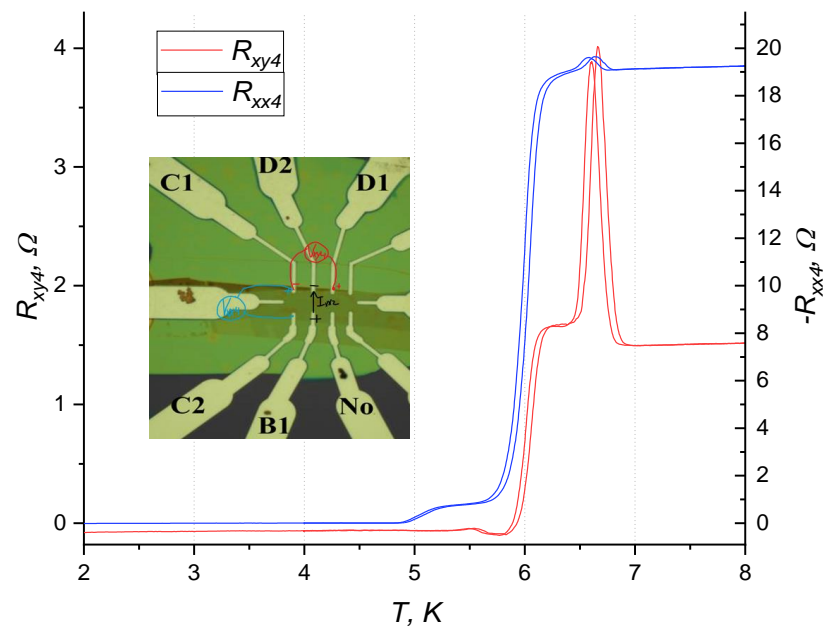
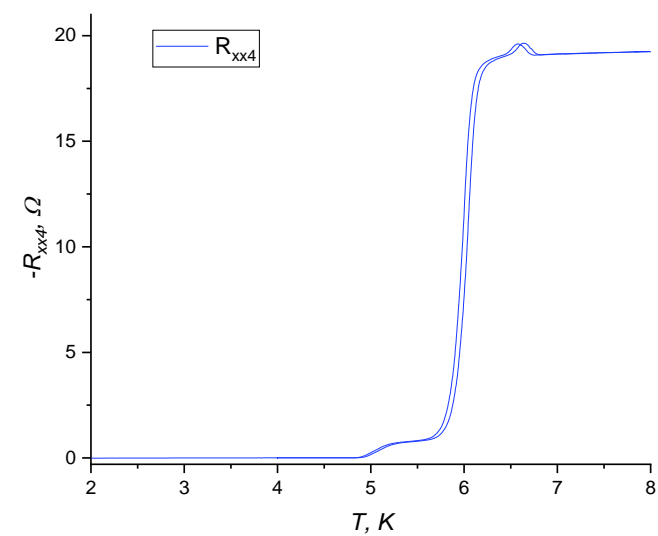
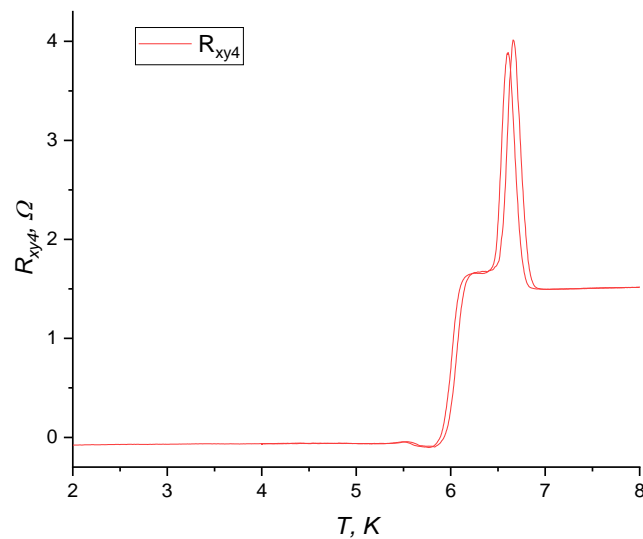
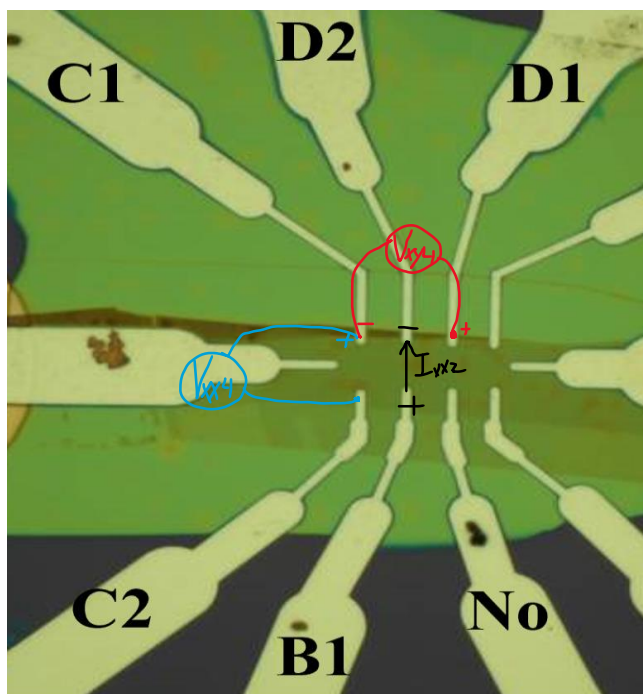
# Сверхпроводимость. Температурная зависимость в нулевом поле

$$I_{xx2} = 20 \mu A, B = 0 T$$

B1(+) -> D2(-) токозадающие

C1(+) -> C2(-)  $R_{xx4}$

D1(+) -> C1(-)  $R_{xy4}$



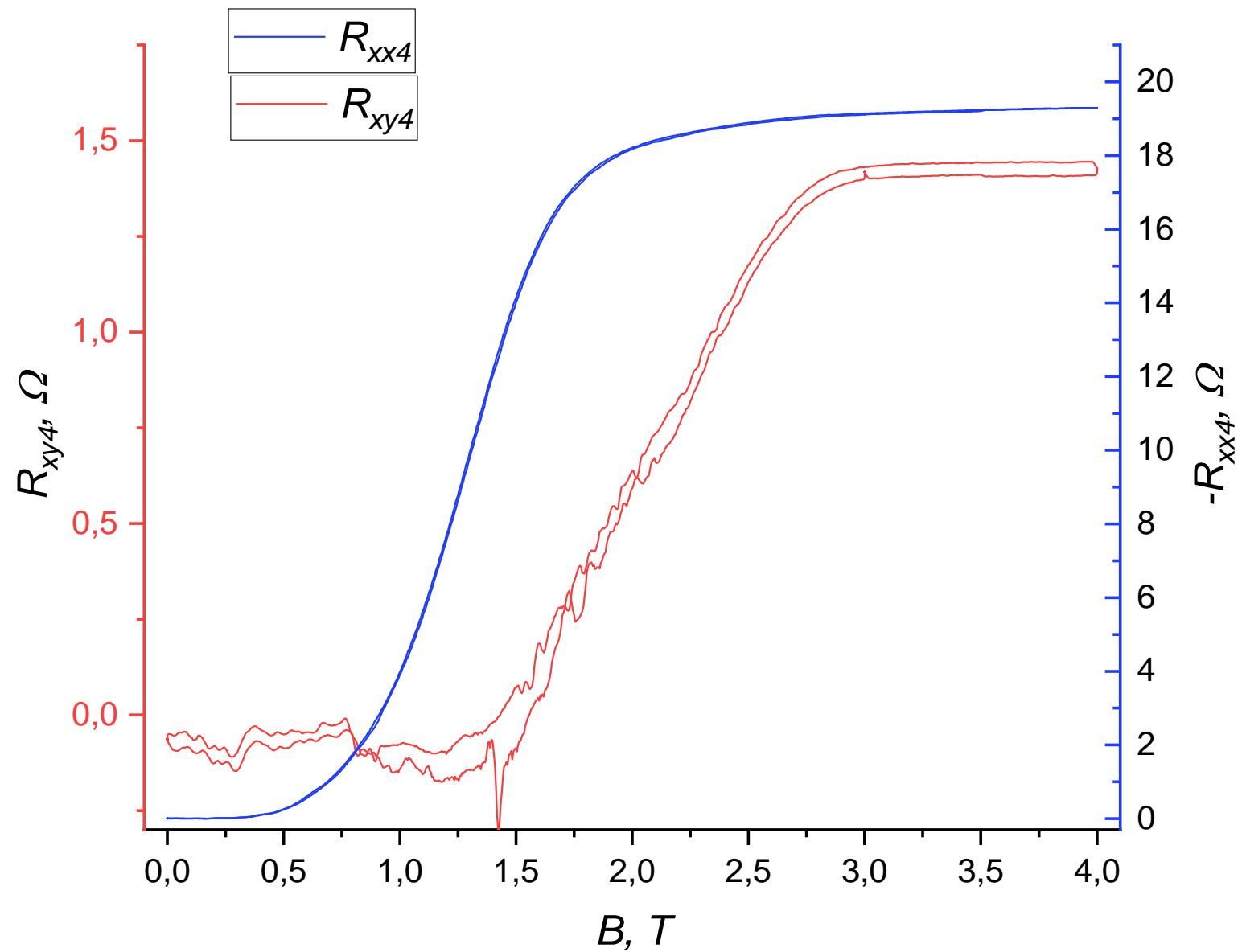
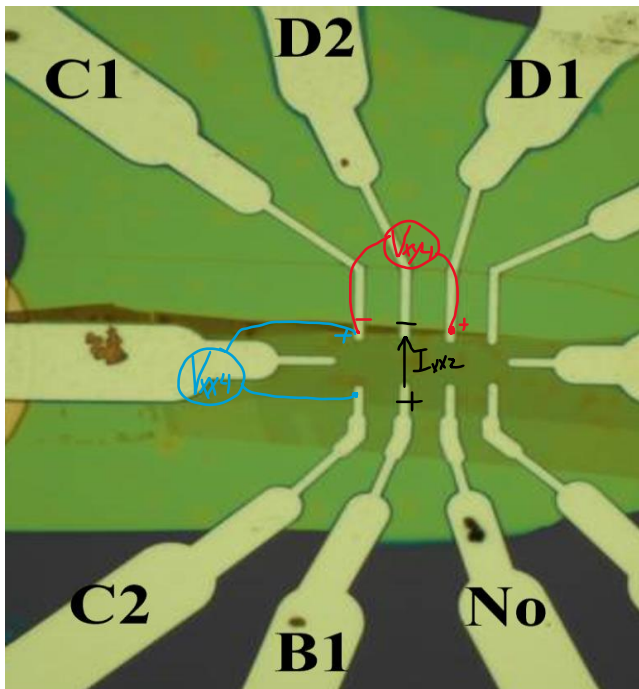
# Сверхпроводимость. Зависимость от поля

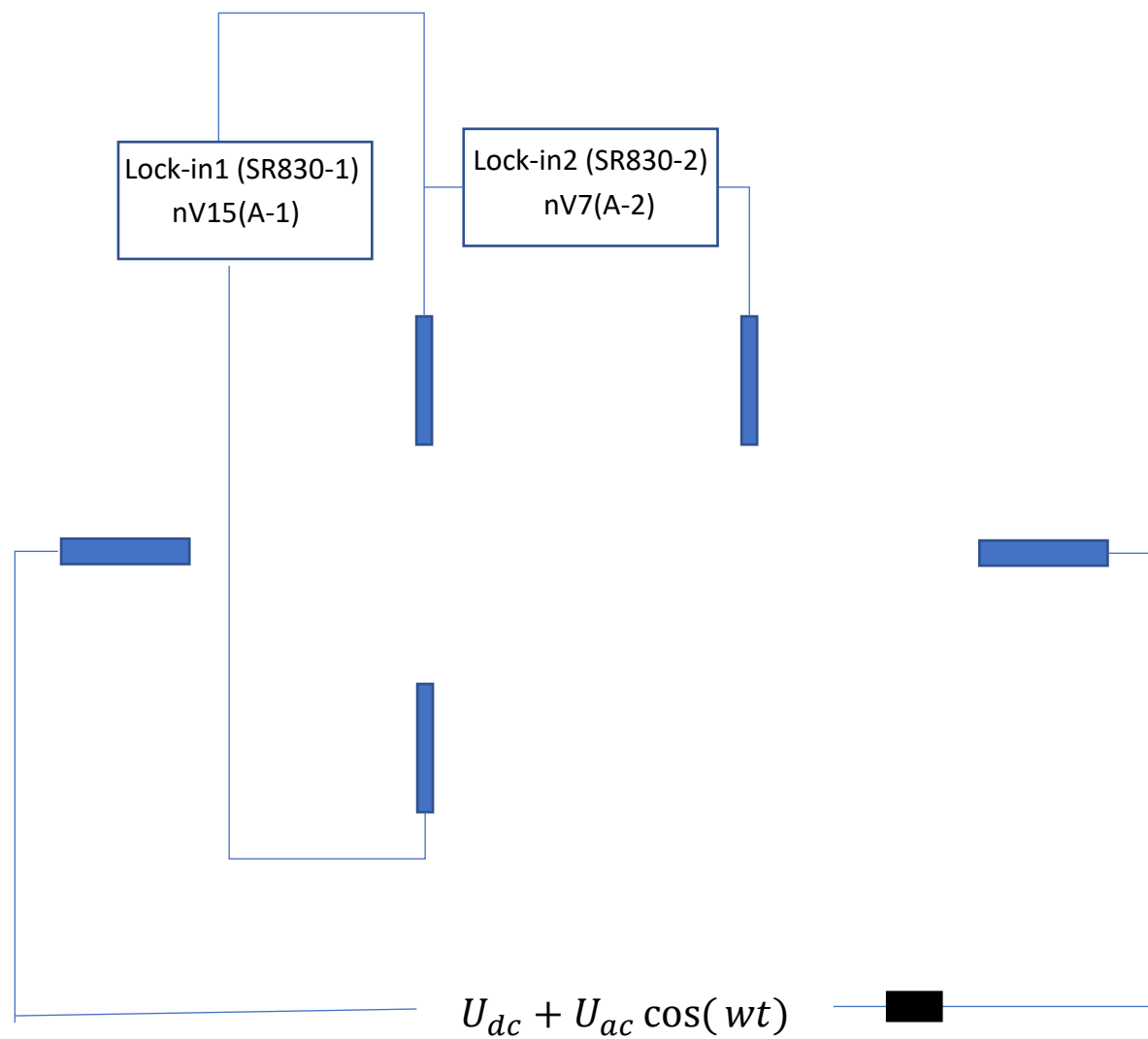
$$I_{xx2} = 20 \mu A, T = 4.0 K$$

B1(+) -> D2(-) токозад.

C1(+) -> C2(-)  $R_{xx4}$

D1(+) -> C1(-)  $R_{xy4}$

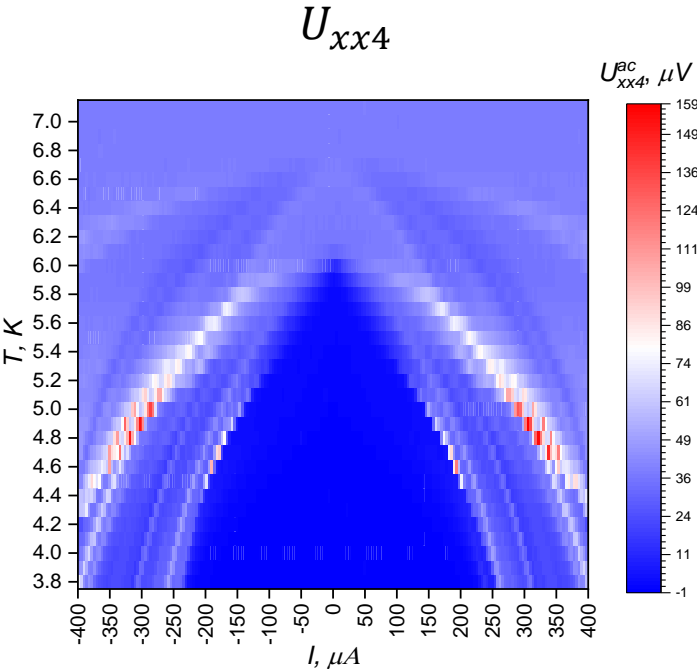




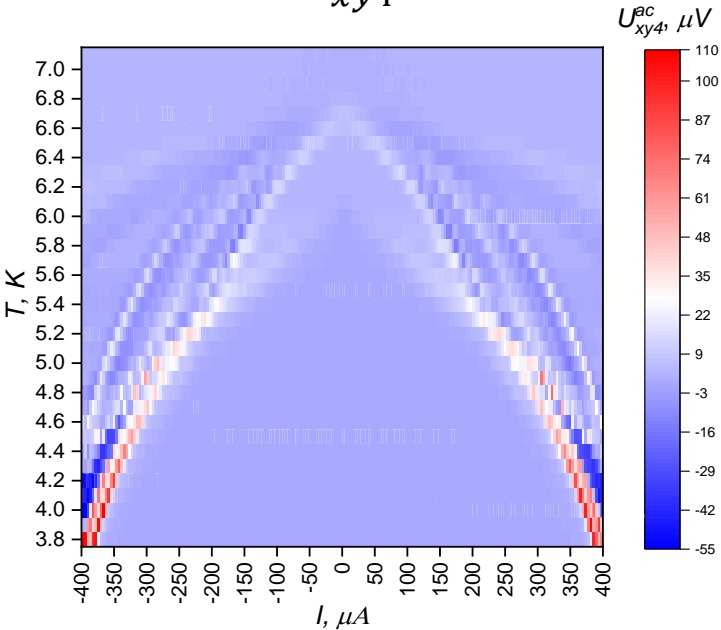
Карты U(T-I). При увеличении тока

Lock-ins

AC

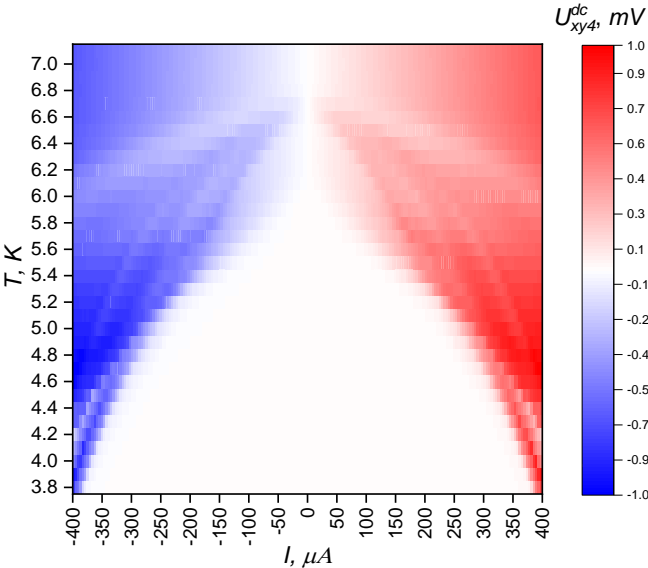
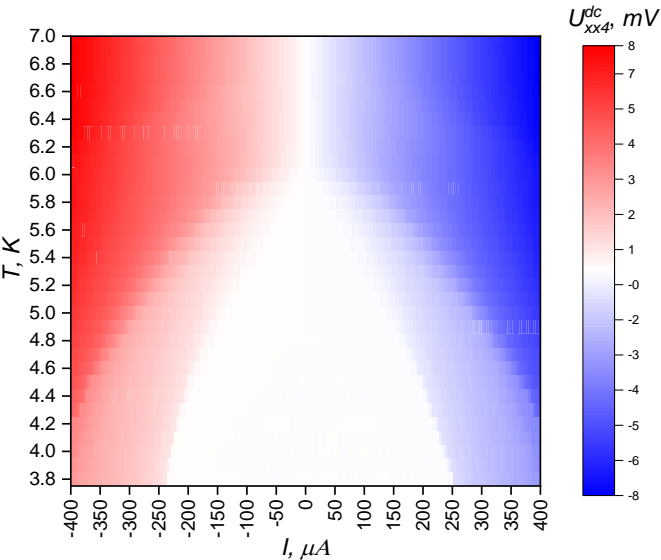


$U_{xy4}$



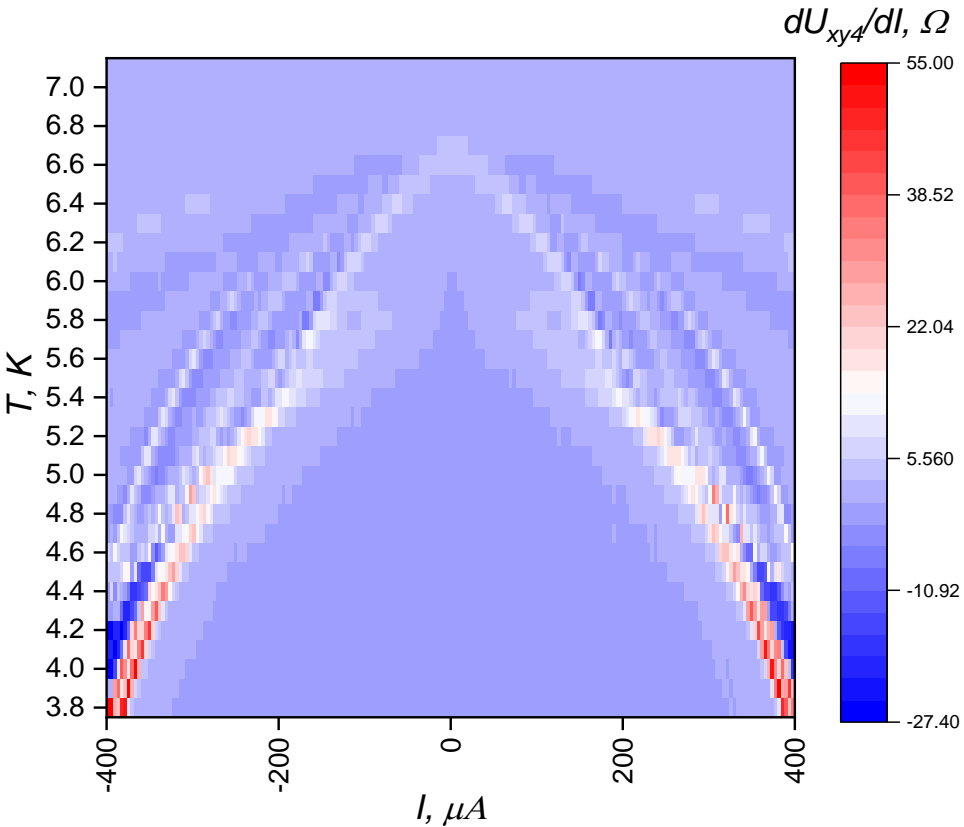
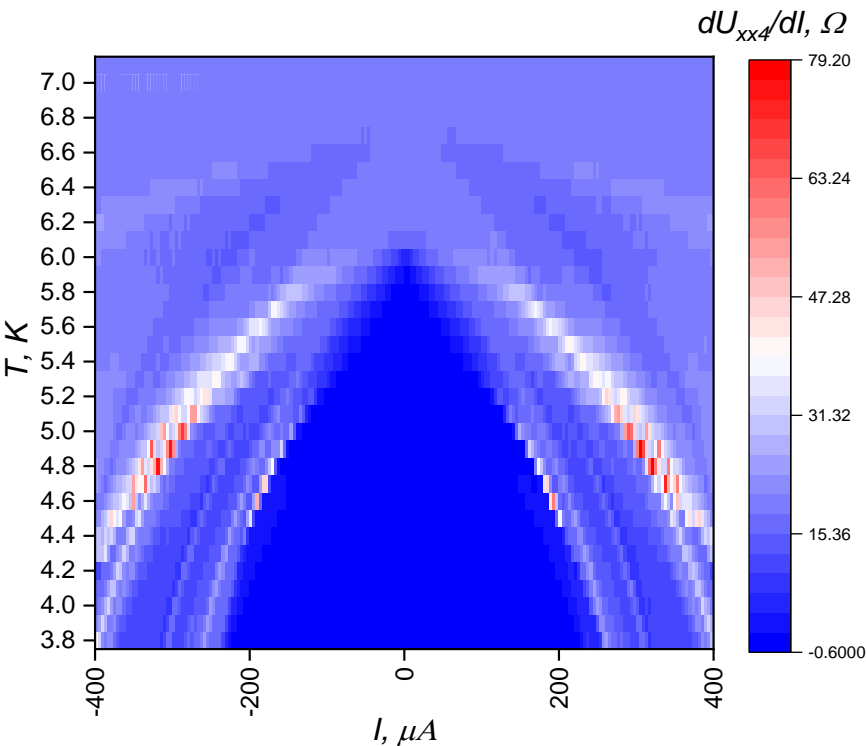
nVs

DC

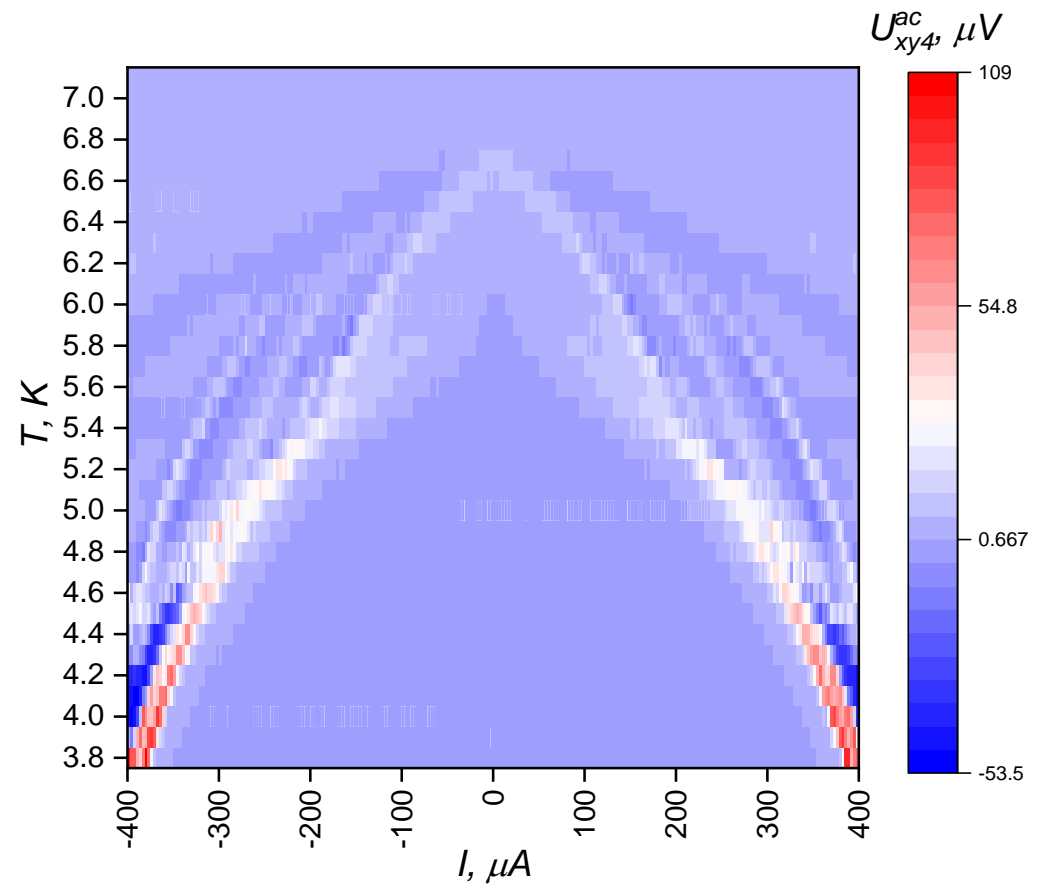
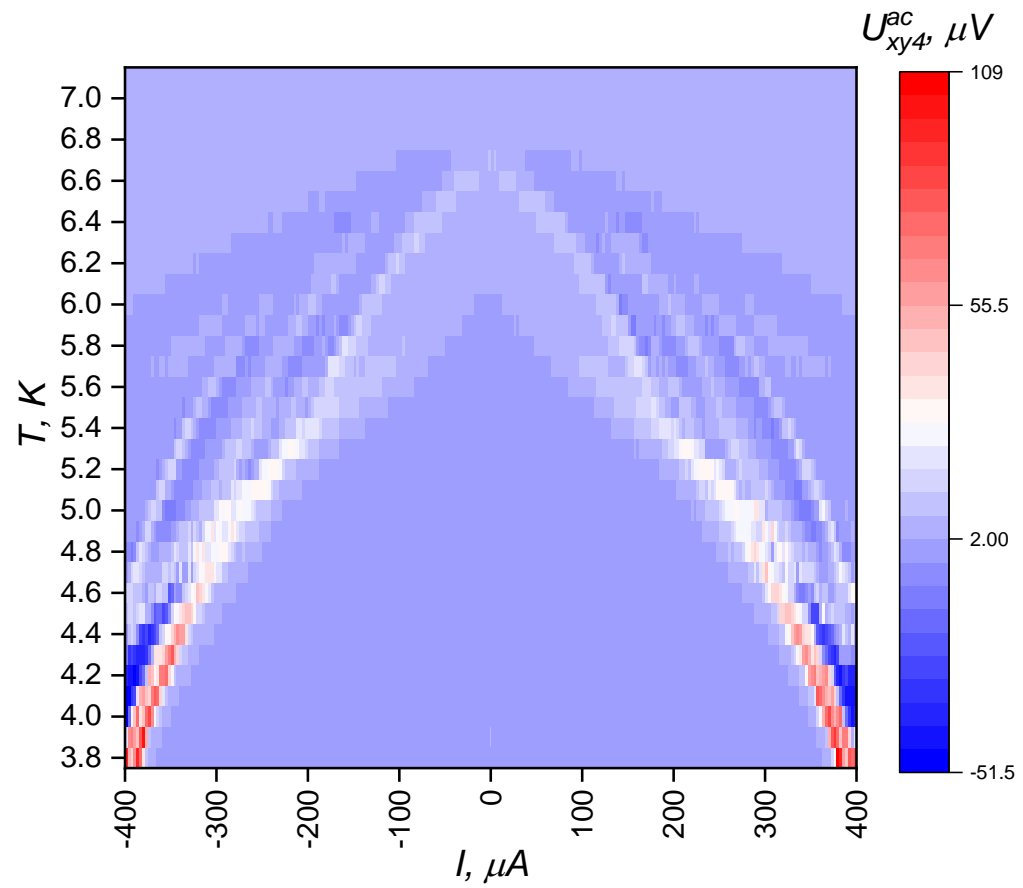


Дифференциальные сопротивления. Данные при направленном увеличении тока

$$I_{ampl\_ac} = 2 \mu A, B = 0 T$$



Гистерезис. incr/decr I.



Разность сигналов для исследования гистерезиса по току.

Разность из данных по возрастанию и по уменьшению тока

